



「デバイスおよび関連材料の開発・製造における インフォマティクス応用とその展望」

◇ 日時: 2025 年 5 月 30 日(金) 13:00~17:10

◇ 場所: 名古屋大学東山キャンパス ES ホール

<https://www.engg.nagoya-u.ac.jp/access/>

デバイスおよび関連材料に求められる要求は多様化・高度化し、その開発スピードは短期間化が求められている。材料探索やプロセス開発の更なる加速にはサイバー空間の活用が必須となっており、シミュレーションに加えて、機械学習や最適化アルゴリズム等を用いることで最適解を短時間で導出することが出来るようになってきた。今回はインフォマティクスの基礎から応用、今後の展望について材料およびプロセスを超えて広く学び、議論する場を提供することを目的とする。

.....プログラム.....

13:00~13:05 開会挨拶

13:05~13:50 材料開発における 4 つのインフォマティクスと自律材料探索

岩崎 悠真 (NIMS)

13:50~14:35 デジタルツインによる SiC 溶液成長プロセス開発とその応用(仮)

宇治原 徹 (名古屋大学)

14:35~15:20 GaN 結晶成長~デバイスプロセスにおけるシミュレーションとインフォマティクス~

寒川 義裕 (九州大学)

15:20~15:35 休 憩

15:35~16:20 シリコンウェーハ製造におけるプロセスインフォマティクス活用(仮)

永井 勇太 (GWJ)

16:20~17:05 半導体デバイス製造プロセスにおけるインフォマティクス活用事例

山本 佳嗣 (三菱電機)

17:05~17:10 閉会挨拶

.....

■参加受付: WEB 参加受付システム ([ここをクリック*](#)) から参加登録と参加費のオンライン決済をお願いします。席数に限りがあるため早期に参加受付を終了することがあります。なお、当日の資料は PDF 版となります。

*本案内が印刷物の場合、<http://annex.jsap.or.jp/adps/pdf/kenkyuukai30.pdf> よりアクセスして下さい。

■参加費: (消費税込)

先進パワー半導体分科会会員* 4,000 円、分科会学生会員 無料、一般 6,000 円、一般学生 1,000 円

*先進パワー半導体分科会賛助会員所属の方は先進パワー半導体分科会会員扱いとします。

■現地開催におけるご協力のお願い: 発熱がある場合は当日のご参加はご遠慮下さい。会場でのマスクの着用は任意とします。

問合せ先:

中川 聡子 (グローバルウェーハズ・ジャパン)	e-mail: Satoko_Nakagawa@sas-globalwafers.co.jp
金村 高司 (ミライズテクノロジーズ)	e-mail: takashi.kanemura.j4y@mirise-techs.com
原田 俊太 (名古屋大学)	e-mail: harada.shunta.i5@f.mail.nagoya-u.ac.jp
太子 敏則 (信州大学)	e-mail: taishi@shinshu-u.ac.jp
白石 陽子 (応用物理学会事務局)	e-mail: shiraishi@jsap.or.jp